【附件三】

教育部基礎深耕計畫（半導體製程設備技術）

科技部MOCVD關鍵零組件技術開發暨人才培育中心

**104年度半導體光電製程設備零組件與系統設計專題競賽**

**《參賽報告書撰寫格式》**

一、內容格式：

依序為封面、作品簡介、參賽照片、報告內容、專題製作心得。

1. 報告封面（p.1）
2. 作品簡介（p.2）
3. 參賽照片（p.3）
4. 報告內容（p.4）：請包括摘要、前言、文獻探討、設計原理分析、參賽團隊分工合作方式、成果及預期結果、結論、參考文獻、附件等，本格式說明僅為統一成果報告之格式，以供撰寫之參考，並非限制研究成果之呈現方式，並以10頁之內為原則(含目錄、參考文獻及附件)。
5. 專題製作心得（p.5）
6. 頁碼編寫：從目錄下一頁開始以阿拉伯數字1.2.3.……順序標在每頁下方中央。

二、打字編印注意事項：

(一)用紙：

使用A4紙，即長29.7公分，寬21公分。

(二)格式：

中文打字規格為每行繕打，固定行高20pt，行間不另留間距；英文打字規格為Single Space。

(三)字體：

報告之正文以中英文撰寫均可。在字體之使用方面，英文使用Times New Roman Font，中文使用標楷體，字體大小請以12號為主。

三、入圍決賽之隊伍請於104年9月25日前將參賽報告書email至承辦人信箱LTWei@ncu.edu.tw，報告書採用PDF或WORD格式，單檔請勿超過10MB，如有特殊情況請與計畫中心聯繫。(檔案轉成PDF檔時，請注意圖片解析度需清晰，圖片勿糢糊不清，謝謝！)

教育部基礎深耕計畫（半導體製程設備技術）

科技部MOCVD關鍵零組件技術開發暨人才培育中心

**104年度半導體光電製程設備零組件與系統設計專題競賽**

**參賽報告書**

題目：

組別：□大專組 □研究所組

學校/系所：

指導老師：

參賽成員： （隊長）

中華民國 年 月 日

**簡 介**

請勿更改此版面格式、標題，以利大會後續排版事宜!內容不要超過1頁。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，謝謝。)

**參賽照片**

1.團隊隊員照片(1張)

2.參賽作品照片(至多2張)

**目 錄**

請依規定格式：**中文為標楷體，英文、數字皆為Times New Roman，12號字，固定行高20pt，段落間距前、後段各0行**撰寫報告，總頁數(包含此目錄頁)以不超過10頁為限。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，謝謝。)

1. 摘要
2. 前言與文獻回顧
3. 設計原理分析
4. 參賽團隊分工合作方式
5. 成果及預期結果
6. 結論
7. 參考文獻
8. 附件

**專題製作心得**

請勿更改此版面格式、標題，以利大會後續排版事宜!內容不要超過1頁。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，